

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成18年4月6日(2006.4.6)

【公開番号】特開2000-338686(P2000-338686A)

【公開日】平成12年12月8日(2000.12.8)

【出願番号】特願平11-150032

【国際特許分類】

G 03 F	7/42	(2006.01)
H 01 L	21/308	(2006.01)
H 01 L	21/027	(2006.01)
H 01 L	21/302	(2006.01)

【F I】

G 03 F	7/42	
H 01 L	21/308	Z
H 01 L	21/30	5 7 2 A
H 01 L	21/302	4 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成18年1月17日(2006.1.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】硝酸と硫酸および/またはリン酸との水溶液であることを特徴とするサイドウォール除去液。

【請求項2】硝酸濃度が0.01重量%~50重量%である請求項1記載のサイドウォール除去液。

【請求項3】硫酸および/またはリン酸濃度が0.001~30重量%である請求項1または2記載のサイドウォール除去液。

【請求項4】請求項1~3のいずれかに記載の液を用いたサイドウォール除去方法。

【請求項5】請求項1~3のいずれかに記載の液にサイドウォールが付着した基板を浸漬させ、その後水 rinsing し、続いて乾燥させるサイドウォール除去方法。

【請求項6】半導体製造工程でのドライエッティングの際に発生するサイドウォールを請求項1~3のいずれかに記載のサイドウォール除去液で洗浄する工程を含むことを特徴とするレジストパターンの形成方法。

【請求項7】請求項4または5に記載の方法により洗浄された構造体。